## 科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 26 年 5 月 9 日現在

機関番号: 5 4 3 0 1 研究種目: 基盤研究(C) 研究期間: 2011 ~ 2013

課題番号: 23560144

研究課題名(和文)アルミニウムナノインプリント法によるダイヤモンドエミッタの開発

研究課題名(英文) Development of diamond emitters by aluminum-nanoimprint method

研究代表者

清原 修二(KIYOHARA, Shuji)

舞鶴工業高等専門学校・電子制御工学科・准教授

研究者番号:40299326

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,500,000円、(間接経費) 750,000円

研究成果の概要(和文): GLCドットアレイモールドを用いたRTCIL (room-temperature curing imprint-liftoff) 法により,DLCドッアレイパターンの形成を行った結果,以下のことが得られた。RTCIL法の最適インプリント条件は,保持時間5 min,インプリント圧力0.5 MPaであった。アルミニウム膜に対するDLC膜の選択比は,酸素イオンエネルギー0.0 eVで最大35となり,高さ400 nmを得るためのアルミニウムの膜厚は20 nmであることがわかった。この手法により,5 µm角,高さ400 nmの凸形状のDLCドットアレイパターンを形成することができた。

研究成果の概要(英文): We investigated the nanofabrication of diamond-like carbon (DLC)-dot arrays by roo m-temperature curing imprint-liftoff method using aluminum mask. The DLC film was used as the patterning m aterial. A glass-like carbon (GLC) was used as a mold material. The polysiloxane was used as EB resist and oxide mask material in EB lithography, and also used as RTC-imprint resist material. An Al was used as ox ide metal mask material of liftoff. We have fabricated the GLC mold of dot arrays with 5000 nm-square and 500 nm-height. Al film on the imprinted polysiloxane was prepared by vacuum evaporation method and its thi ckness is 20 nm. Finally, the polysiloxane patterns were removed with acetone and Al mask patterns were fa bricated. The maximum etching selectivity of Al film against DLC film was as high as 35, which was obtaine d under 400 eV-ion energy. Then we processed the patterned Al on DLC film with an ECR oxygen ion shower. W e fabricated DLC-dot arrays with 5000 nm-squarer and 400 nm-height.

研究分野: 機械工学

科研費の分科・細目: 生産工学・加工学

キーワード: ナノインプリント ダイヤモンドライクカーボン ナノ加工 ポリシロキサン 酸素イオンシャワー

ガラス状炭素

#### 1.研究開始当初の背景

本研究では,モールド作製プロセスに使用 する 電子ビーム (Electron Beam: EB) レ ジストにポリシロキサン[-R2SiO-]nを使用し ている。ポリシロキサンはネガ型の露光特性 を持ち,酸化シリコン(SiO)を主成分とす ることから,酸素イオンに対する加工耐性を もつため,直接酸化マスクとして使用できる。 このことから,ポリシロキサンを酸化マスク とした電子サイクロトロン共鳴 (Electron Cyclotron Resonance: ECR)酸素イオン シャワー加工によるモールドの作製プロセ スを提案した。また,一般的に用いられる熱 サイクル-NIL は熱可塑性樹脂の軟化のため の加熱・冷却プロセスが必要となる。そのた め,プロセスが複雑になることや,温度変化 によるモールドの膨張・収縮により転写パタ ーン精度の低下が問題となる。これまでに本 研究で開発したガラス状炭素 (Glass-like Carbon: GLC)モールドを使用した室温硬化 (Room-temperature Curing: RTC) -NIL によって, 高精度なダイヤモンド薄膜のパタ ーンが形成できることがわかっている。しか し,本研究で作製した凹型パターンのモール ドでは,高精度な転写パターンが得られなか った。さらに,マスク材料として使用してい たポリシロキサンは、DLCに対する酸素イオ ン加工耐性が小さく, 凸型のモールドでイン プリントするため最終的なダイヤモンドラ イクカーボン (Diamond-like Carbon: DLC)のパターン形状は凹型となる。そのた め,機能性マイクロデバイスの作製が難しい ことがわかった。

#### 2.研究の目的

本研究では、ダイヤモンドの ナノ加工プロセスとして、室温硬化インプリント・リフトオフ(Room-temperature curing imprint liftoff: RTCIL)法を提案した。本研究ではマスク材料としてポリシロキサンを使用してきたが、酸素イオンに対する加工耐性が小

さく、機能性マイクロデバイスの作製は難しいことがわかった。そこで、酸素イオンに対する加工耐性が大きいことが期待できるアルミニウム(Al)を新たなマスク材料として提案した.また、負の電子親和力を持ち、優れた電子放出特性が得られ、フラットパネルディスプレイ用 ナノエミッタの材料として期待できる DLC をパターン材料として提案した.そこで本研究では、RTCIL 法によりDLC マイクロドットアレイの作製について検討した。

#### 3. 研究の方法

#### (1) コンパクトナノインプリントシステム の開発

本研究では,DC コアレスモータ駆動型コ ンパクトインプリントシステムを開発した。 しかし、このシステムでは圧力を一定(誤 差:30%)にすることができず,ポリシロキ サンが硬化している最中に圧力が下がって しまうため,パターン形状が歪んでしまった. そこで,新たにステッピングモータ駆動型コ ンパクトインプリント(高さ300mm,幅300 mm, 奥行 300 mm) システムを開発した。 その仕様と概略をそれぞれ表1および図1に 示す。ステッピングモータ(分解能:0.5 um/pulse )「PMM33BH2-C30,シグマ光機(株)」 は,過負荷もしくは高パルスの場合に脱調す るため, 高圧力をかけても壊れることがない 利点がある。インプリント圧力の測定には, 歪みを電気信号に変換して圧力測定を行う ストレインゲージ式ロードセル 「LC1205-K050,(株)エー・アンド・デイ]を 用いた。また,パーソナルコンピュータと口 ードセルのディジタルインジケータを RS-232C を使用して接続することにより,圧 力値を一定値に制御(誤差:5%)でき,ま た全自動によるインプリントが可能となっ た.そのため,より高精度なインプリントを 実現できると考えられる。

表 1 インプリントシステムの仕村	表 1	インプリン	トシステム	ムの仕様
-------------------	-----	-------	-------	------

-			
サイズ	高さ 300 mm , 幅 300 mm , 奥行 300 mm		
分解能	0.5 μm/pulse		
操作	PC からのディジタル位置制御		
方法	(ステップ & リピート 可能)		
	ストレインゲージ式ロードセル		
圧力	( LC1205-K050,		
測定	A & D CO., LTD. )		
	ステッピングモータ		
駆動力	( PMM33BH2-C30,		
	SIGMA KOKI CO., LTD. )		
Z軸	1 5 105/-		
速度	$1 \sim 5 \times 10^5 \mu\text{m/s}$		

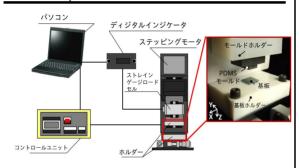


図 1 本研究で開発したインプリント システムの概略

# (2) RTCIL 法による DLC のマイクロ加工 プロセス

本研究で開発したRTCIL法によるDLCドットアレイの作製プロセスを図 2 に示す。図に示すように,室温で徐々に硬化するポリシロキサン [HSG-R7-13,日立化成工業(株)]をスピンコート後,0.5 MPa でインプリントを行った。その後,DLCに対する AI の選択比が 35 であることから,高さ 400 nm を得るため,膜厚が 20 nm となるようにポリシロキサン膜上に AI を蒸着した。その後,アセトンでポリシロキサンを取り除き,AI のマスクパターンを形成した。この基板に最適加工条件のイオンエネルギー400 eV,10 分で ECR酸素イオンシャワー加工することより,DLCドットアレイを作製した。

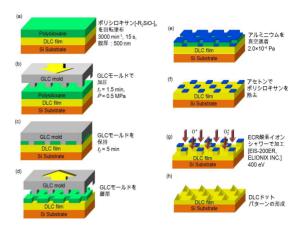


図 2 GLC モールド RTCIL 法による DLC ドットアレイパターン形成プロセス

#### 4 . 研究成果

本研究で開発した RTCIL 法により, DLC ドットアレイパターンを形成した。本研究で 作製した 5 μm 角, モールド高さ 500 nm の 四角柱ドットを有する GLC ドットアレイモ ールド(a)を用いてインプリントし、アルミ ニウムを蒸着した後,ポリシロキサンを取り 除いたリフトオフ後のアルミニウムマスク パターン(b)と、その試料の ECR 酸素イオ ンシャワー加工後の DLC ドットアレイ (c) の SEM 像とその断面プロファイルを図 3 に 示す。図に示すように, GC ドットアレイモ ールド(a), アルミニウムマスクパターン(b) を比較すると,5 μm 角のアルミニウムマス クパターンが形成できており,高精度なパタ ーンを形成できていることがわかった。これ は,インプリントする際 DLC 膜までインプ リントすることができ,そこにアルミニウム を蒸着したため,モールドと同形状のパター ンが形成できたためと考えられる。また,ア ルミニウムマスクパターン(b), DLC ドット アレイ(c)を比較すると 5 μm 角 , 高さ 20 nm の DLC ドットアレイパターンが形成できる ことがわかった。

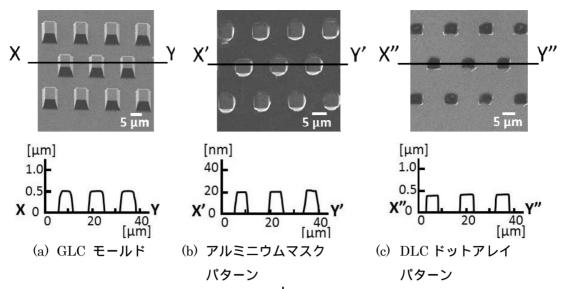


図 3 GLC モールド RTCIL 法による DLC ドットアレイパターン形成

1.0 ,5.0 μm 角の GLC ドットアレイモールドを用いてインプリントを行った結果 ,5 μm 角の GLC ドットアレイモールドでのみ ,リフトオフ後に DLC 膜上に膜厚 Al マスクパターンが形成できた。しかしながら ,目標としていた先鋭化された DLC ドットパターンは得られなかった。これは ,本研究で用いたDLC 膜厚が 500 nm であり ,DLC 膜の形状変化シミュレーションから ,形成した 5 μm 角の Al マスクパターンでは ,先鋭化するまでに DLC 膜厚が 17 μm 以上必要であったためである。

#### 5 . 主な発表論文等

#### 〔雑誌論文〕(計7件)

清原修二,石川一平,松田将平:PDMS モールドを用いた室温硬化ナノインプリント法による DLC のナノ加工技術,コンバーテック,査読無,Vol.42,No.3,2014,36-40 清原修二,石川一平,松田将平:室温ナノインプリント法による DLC の超微細加工,NEW DIAMOND,査読無,Vol.29,No.4,2013,24-26

I. Ishikawa, K. Sakurai, S. Kiyohara, C.

Ito, H. Tanoue, Y. Suda, H. Takikawa, Y. Taguchi, Y. Sugiyama, Y. Omata, Y. Kurashima: Fabrication of Micro-OLEDs by Room-temperature Curing Contact-imprint Using DLC Molds, Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 查読有, Vol.1511, 2013, mrsf12-1511-ee05-03, doi: 10.1557/opl.2012.1711

S. Kiyohara, S. Matta, I. Ishikawa, H. Tanoue, H. Takikawa, Y. Taguchi, Y. Sugiyama, Y. Omata, Y. Kurashima, Nanofabrication of DLC-dot Arrays by Room-temperature Curing Imprint-liftoff Method, Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 查 読有, Vol.1511, 2013, mrsf12-1511-ee05-02, doi: 10.1557/opl.2013.15

S. Kiyohara, T. Ikegaki, I. Ishikawa, H. Tanoue, H. Takikawa, Y. Taguchi, Y. Sugiyama, Y. Omata, Y. Kurashima, Fabrication of DLC-based Micro-gear patterns by Room-temperature Curing Nanoimprint Lithography Using Glass-like Carbon Molds, Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 查 読 有, Vol.1511, 2013 mrsf12-1511-ee05-01,

doi:10.1557/opl.2013.21

S. Kiyohara, T. Ikegaki , <u>I. Ishikawa</u> , H. Tanoue, H. Takikawa , Y. Taguchi , Y.

Sugiyama , Y. Omata , Y. Kurashima, Fabrication of DLC-based Micro-gear patterns by Room-temperature Curing Nanoimprint Lithography Using Glass-like Carbon Molds, Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 查 読 有 , Vol.1511, 2013 mrsf12-1511-ee05-01,

doi:10.1557/opl.2013.21

S. Kiyohara, C. Ito, I. Ishikawa, H. Takikawa, Y. Taguchi, Y. Sugiyama, Y. Omata and Y. Kurashima: Fabrication of Diamond Nanopit arrays by Room-temperature Curing Nanoimprint Lithography Using Glass-like Carbon Molds, Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 查読有, Vol.1395, 2012, 27-32

#### [学会発表](計24件)

松本拓也,<u>石川一平</u>,<u>清原修二</u>,櫻井圭輔,田上英人,須田善行,滝川浩史,渡邊雅彦,杉山嘉也,小俣有紀子,倉島優一:はしご型 HSQ を用いた室温硬化ナノインプリント法による超微細有機 ELの開発,日本高専学会第19回年会講演会,平成25年8月31日,高知工業高等専門学校

櫻井圭輔,石川一平,清原修二,田上英人,須田善行,滝川浩史,田口佳男,杉山嘉也,小俣有紀子,倉島優一:室温硬化ナノインプリント法による有機 EL 超微細加工に関する研究,2013 年度精密工学会関西地方定期学術講演会,平成25年6月14日,大阪工業大学 大宮キャンパス

松田将平,清原修二,石川一平,田上英人,滝川浩史,田口佳男,杉山嘉也,小俣有紀子,倉島優一:はしご型 HSQ を用いたPDMS モールド室温硬化ナノインプリント法による DLC ナノドットアレイのパターン形成,2013 年度精密工学会関西地方定期学術講演会,平成25年6月14日,大阪工業大学 大宮キャンパス

櫻井圭輔,石川一平,清原修二,田口佳男,杉山嘉也,小俣有紀子,田上英人,須田善行,滝川浩史,倉島優一:DLCモールドを用いた室温硬化ナノインプリントリソグラフィによる超微細有機 ELの作製,ナノ学会第11回大会,平成25年6月7日,東京工業大学 百年記念館

松田将平,清原修二,石川一平,田口佳男,杉山嘉也,小俣有紀子,田上英人,滝川浩史,倉島優一:室温硬化インプリント-リフトオフ法による DLC ドットアレイの作製,

ナノ学会第 11 回大会,平成 25 年 6 月 6 日, 東京工業大学 百年記念館

辻賢介,石川一平,清原修二,須田善行,田口佳男,杉山嘉也,小俣有紀子,倉島優一:グラフェンデバイス作製を目指したインプリントリソグラフィ法による超微細構造薄膜の形成,日本高専学会第18回年会,平成24年8月25日,近畿大学工業高等専門学校

S. Kiyohara, T. Ikegaki, I. Ishikawa, H. Tanoue, H. Takikawa, Y. Taguchi, Y. Sugiyama, Y. Omata, Y. Kurashima, Fabrication of DLC-based Micro-gears by Room-temperature Curing Nanoimprint Lithography Using Glass-like Carbon Molds, 2012 Materials Research Society Fall Meeting, 26 Novemver 2012, Hynes Covention Center and Sheraton Boston Hotel

S. Kiyohara, S. Matta, I. Ishikawa, H. Tanoue, H. Takikawa, Y. Taguchi, Y. Sugiyama, Y. Omata, Y. Kurashima: Nanofabrication of DLC-dot Arrays by Room-temperature Curing Imprint-liftoff Method, 2012 Materials Research Society Fall Meeting, 26 Novemver 2012, Hynes Covention Center and Sheraton Boston Hotel

I. Ishikawa, K. Sakurai, S. Kiyohara, C. Ito, H. Tanoue, Y. Suda, H. Takikawa, Y. Taguchi, Y. Sugiyama, Y. Omata, Y. Kurashima: Fabrication of Micro-OLEDs by Room-temperature Curing Contact-imprint Using DLC Molds, 2012 Materials Research Society Fall Meeting, 26 Novemver 2012, Hynes Covention Center and Sheraton Boston Hotel

辻賢介,石川一平,清原修二,須田善行,田口佳男,杉山嘉也,小俣有紀子,倉島優一:グラフェンデバイス作製を目指したインプリントリソグラフィ法による超微細構造薄膜の形成,日本高専学会第18回年会,平成24年8月25日,近畿大学工業高等専門学校池垣斗夢,清原修二,石川一平,滝川浩田,北川吉田,小俣石紀子,命島

史,田口佳男,杉山嘉也,小俣有紀子,倉島優一:室温硬化ナノインプリントによるポリジメチルシロキサン酸化マスクパターンの形成,2012 年度精密工学会関西地方定期学術講演会,平成24年6月15日,立命館大学びわこ・くさつキャンパス

松田将平,<u>清原修二</u>,<u>石川一平</u>,滝川浩 史,田口佳男,杉山嘉也,小俣有紀子,倉島 優一:室温硬化ナノインプリント-リフトオフ 法による DLC ナノエミッタの開発,2012 年 度精密工学会関西地方定期学術講演会,平成 24 年 6 月 15 日,立命館大学 びわこ・くさ フキャンパス

伊藤茅,<u>石川一平</u>,<u>清原修二</u>,滝川浩史,田口佳男,杉山嘉也,小俣有紀子,倉島優一:室温硬化インプリントによる医療 MEMS 用DLC マイクロギアの作製,2012 年度精密工

学会関西地方定期学術講演会,平成 24 年 6 月 15 日,立命館大学 びわこ・くさつキャ ンパス

伊藤茅,清原修二,石川一平,滝川浩史,田口佳男,杉山嘉也,小俣有紀子,倉島優一:室温硬化ナノインプリントによる医療マイクロマシン用ダイヤモンドキアの作製,ナノ学会第10回大会,平成24年6月14日,大阪大学 豊中キャンパス

奥野泰佑, $\overline{\Delta | | -\Psi}$ , $\overline{\underline{a} | | -\Psi}$ ,用口佳男,杉山嘉也,小俣有紀子,須田善行,倉島優一:室温硬化ナノインプリントリソグラフィ法による微細 OLED の作製,ナノ学会第 10 回大会,平成 24 年 6 月 14 日,大阪大学豊中キャンパス

松田将平,清原修二,石川一平,田口佳男,杉山嘉也,小俣有紀子,倉島優一:室温硬化ナノインプリントリソグラフィによるPDMS酸化マスクパターンの形成,ナノ学会第10回大会,平成24年6月14日,大阪大学 豊中キャンパス

池垣斗夢,<u>清原修二</u>,<u>石川一平</u>,田口佳男,杉山嘉也,小俣有紀子,滝川浩史,倉島優一:室温硬化ナノインプリント・リフトオフ法によるアルミニウムマスクパターンの形成,ナノ学会第10回大会,平成24年6月14日,大阪大学 豊中キャンパス

田上英人,柏木大幸,奥田浩史,須田善行, 滝川浩史,川島貴弘,柴田隆行,<u>清原修二</u>, 田口佳男,杉山嘉也,小俣有紀子,神谷雅男, 瀧真,長谷川祐史,辻信広,石川剛史,水素 フリー高密度 DLC 膜のパターニング,単離 およびハンドリング,2012 年春季第59回応 用物理学関係連合講演会講演予稿集,応用物 理学会,早稲田大学,平成24年3月

H. Tanoue, T. Kashiwagi, H. Okuda, Y. Suda, H. Takikawa, M. Kamiya, S. Kiyohara, T. Kawashima, T. Shibata, Y. Taguchi, Y. Sugiyama, Y. Omata, M. Taki, Y. Hasegawa, N. Tsuji and T. Ishikawa: Patterning of Tetrahedral Amorphous-Carbon Film by Electron Beam Lithography and Pick Up from Si-Wafer in Beam System, Focused Ion International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials, 5p-C02OC, (Chubu University, Aichi, Japan, 2012.03.4-8)

S. Kiyohara, C. Ito, <u>I. Ishikawa</u>, H. Takikawa, Y. Taguchi, Y. Sugiyama, Y. Omata and Y. Kurashima: Fabrication of Diamond Nanopit Arrays by Room-temperature Curing Nanoimprint Lithography Using Glass-like Carbon Molds, 2011 Materials Research Society Fall Meeting ABSTRACTS (2011) p.N12-2. (Hynes Covention Center and Sheraton Boston Hotel, Boston, Massachusetts, USA, 30 Novemver 2011)

21 I. Ishikawa, T. Okuno, S. Kiyohara, Y. Taguchi, Y. Sugiyama, Y. Omata and Y. Kurashima: Micro-Organic Light-Emitting Devices Fabricated by Room-Temperature Curing Nanoimprint Lithography Using Diamond Molds, 2011 Materials Research Society Fall Meeting ABSTRACTS (2011) p.N12-4. (Hynes Covention Center and Sheraton Boston Hotel. Massachusetts, USA, 30 Novemver 2011) 22 T. Kashiwagi, H. Okuda, H. Tanoue, Y. Suda, H. Takikawa, M. Kamiya, S. Kiyohara, T. Kawashima, T. Shibata, Y. Taguchi, Y. Sugiyama, Y. Omata, M. Taki, Y. Hasegawa, N. Tsuji and T. Ishikawa: Patterning of Tetrahedral Amorphous Carbon Film bv Electron Lithography, The Asia-Pacific Interdisciplinary Conference Research 2011. 18PP-70, p.172(Tovohashi University of Technology, Toyohashi, Aichi, Japan, 18 Novemver 2011)

23 柏木大幸, 奥田浩史, 角口公章, 田上英人, 須田善行, 滝川浩史, 神谷雅男, 瀧真, 長谷川祐史, 辻信広, 石川剛史, <u>清原修二</u>: フィルタードアーク蒸着で形成した DLC 膜の酸素イオンエッチング, 平成 23 年度電気関係学会東海支部連合大会, p.O1-1 (電気関係学会東海支部連合大会, 三重大学, 平成 23年9月 26日)

24伊藤茅,<u>石川一平</u>,<u>清原修二</u>,田口佳男, 杉山嘉也,小俣有紀子,倉島優一,滝川浩史: ガラス状炭素モールド室温硬化インプリントによるダイヤモンドナノピットパターン 形成,2011年度精密工学会関西地方定期学 術講演会講演論文集,pp.56-57.(精密工学 会,兵庫県立大学 姫路書写キャンパス,平 成23年6月30日)

# 〔その他〕

ホームページ等

http://www.maizuru-ct.ac.jp/control/kiyoha ra/index.html

#### 6.研究組織

### (1)研究代表者

清原 修二(KIYOHARA, Shuji)

舞鶴工業高等専門学校・電子制御工学科・ 准教授

研究者番号: 40299326

#### (2)研究分担者

石川 一平 (ISHIKAWA, Ippei)

舞鶴工業高等専門学校・電子制御工学科・ 講師

研究者番号:10511735